








	<h2 style="color: red;">FQD12N20TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD12N20TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD12N20TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD12N20TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16142 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD12N20TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	16142 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD12N20TM-ND

FQD12N20TM ist neu im Original. Suche FQD12N20TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12N20TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD12N20TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD12N20TM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD12N20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD12P10</b> FAIRCHI FQD12P10 FAIRCHI</p>
 <p><b>FQD12P10TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD12N20TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD12N20LTM_SN00173</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V DPAK</p>	 <p><b>FQD12N20TM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD10N20D	↔ FQD10N20L	⇒ FQD10N20LTF	D FQD10N20LTF	↔ FQD10N20LTM
⊕ FQD10N20LTM	⊕ FQD10N20TF	D FQD10N20TF	⇒ FQD10N20TM	↔ FQD10N20TM
⊕ FQD11P06	⊕ FQD11P06-NL	⊕ FQD11P06TF	↔ FQD11P06TF	↔ FQD11P06TM
D FQD11P06TM	⊕ FQD12N10	⊕ FQD12N20	⊕ FQD12N20L	↔ FQD12N20LTF
⇒ FQD12N20LTF	↔ FQD12N20LTM	⊕ FQD12N20LTM	⊕ FQD12N20TF	↔ FQD12N20TF
↔ FQD12N20TM	⇒ FQD12P10	D FQD12P10TF	⊕ FQD12P10TF	⊕ FQD12P10TM
⊕ FQD12P10TM	D FQD13N06	⇒ FQD13N06L	↔ FQD13N06LTF	↔ FQD13N06LTF
⊕ FQD13N06LTM	⊕ FQD13N06LTM	↔ FQD13N06LTM-NL	⇒ FQD13N06TF	↔ FQD13N06TF
⊕ FQD13N06TM	⊕ FQD13N06TM	⊕ FQD13N10	D FQD13N10L	↔ FQD13N10LTF
↔ FQD13N10LTF	⊕ FQD13N10LTM	⊕ FQD13N10LTM	⊕ FQD13N10LTM-NL	↔ FQD13N10TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

